

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/055537 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01R 33/09

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003503

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RABE, Maik [DE/DE];
Frederichstr. 8, 70825 Korntal (DE). SIEGLE, Henrik
[DE/DE]; Anne-Frank-Str. 8, 71229 Leonberg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Oktober 2003 (18.10.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 58 860.0 17. Dezember 2002 (17.12.2002) DE

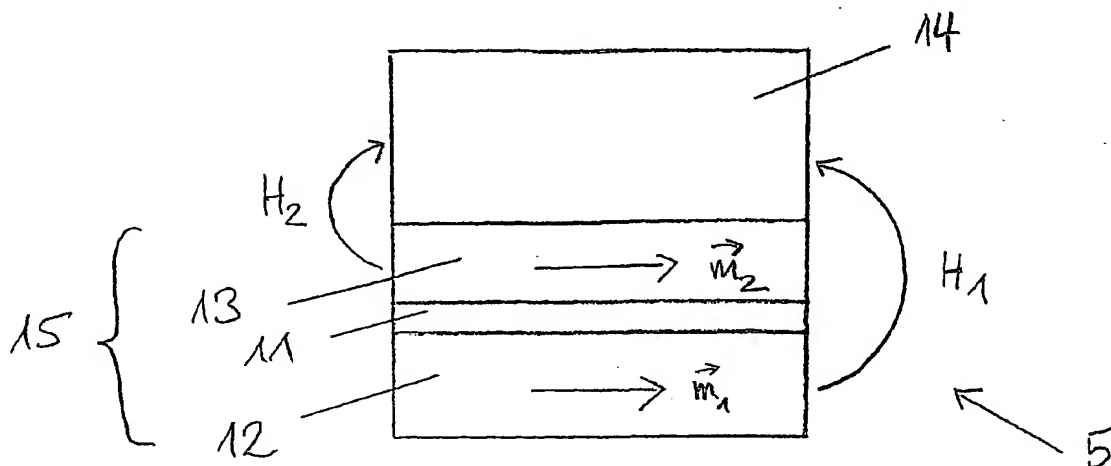
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02
20, 70442 Stuttgart (DE).Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MAGNETORESISTIVE LAYER SYSTEM AND SENSOR ELEMENT WITH SAID LAYER SYSTEM

(54) Bezeichnung: MAGNETORESISTIVES SCHICHTSYSTEM UND SENSORELEMENT MIT DIESEM SCHICHTSYSTEM



(57) Abstract: A magnetoresistive layer system (5) is disclosed, whereby a layer arrangement (15) is provided in an area of a magnetoresistive layer stack (14), working particularly on the basis of the GMR or the AMR effect, which generates a resultant magnetic field which acts on the magnetoresistive layer stack (14). The layer arrangement (15) comprises a first magnetic layer (12) and a second magnetic layer (13), separated from each other by means of a non-magnetic intermediate layer (11) and coupled for ferromagnetic interchange by means of said intermediate layer (11). Furthermore, a sensor element, in particular for the detection of magnetic fields with regards to the strength and direction thereof, comprising such a layer system (5) is disclosed.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein magnetoresistives Schichtsystem (5) vorgeschlagen, wobei in einer Umgebung eines insbesondere auf der Grundlage des GMR- oder AMR-Effektes arbeitenden magnetoresistiven Schichtstapels (14) eine Schichtanordnung (15) vorgesehen ist, die ein resultierendes Magnetfeld erzeugt, das auf den magnetoresistiven Schichtstapel (14) einwirkt. Die Schichtanordnung (15) weist eine erste magnetische Schicht (12) und eine zweite magnetische Schicht (13) auf,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



die über eine nichtmagnetische Zwischenschicht (11) voneinander getrennt und über die Zwischenschicht (11) ferromagnetisch austauschgekoppelt sind. Weiter wird ein Sensorelement insbesondere zu Detektion von Magnetfeldern hinsichtlich Stärke und/oder Richtung mit einem solchen Schichtsystem (5) vorgeschlagen.

Magnetoresistives Schichtsystem und Sensorelement mit diesem Schichtsystem

Die Erfindung betrifft ein magnetoresistives Schichtsystem sowie ein Sensorelement mit diesem Schichtsystem nach den unabhängigen Ansprüchen.

Stand der Technik

Aus dem Stand der Technik sind magnetoresistive Schichtsysteme bzw. entsprechende Sensorelemente beispielsweise für den Einsatz in Kraftfahrzeugen bekannt, bei denen der Arbeitspunkt durch Hilfsmagnetfelder verschoben werden kann. Insbesondere ist die Erzeugung eines Hilfsmagnetfeldes durch montierte makroskopische Hartmagnete oder stromdurchflossene Feldspulen bekannt.

In DE 101 28 135.8 wird daneben ein Konzept erläutert, bei dem eine hartmagnetische Schicht in der Nähe eines magnetoresistiven Schichtstapels, insbesondere auf oder unter dem Schichtstapel, deponiert wird, die vor allem durch ihr Streufeld an die eigentlichen sensitiven Schichten des Schichtstapels ankoppelt. Dabei steht eine möglichst hohe Koerzitivität als Zielparameter sowie andererseits das remanente Magnetfeld als beschränkender Parameter im Vordergrund. Eine solche hartmagnetische Schicht führt bei einer vertikalen Integration jedoch auch zu einem elektrischen Kurzschluss der benachbarten sensitiven Schichten des magnetoresistiven Schichtsystems, was einen erwünschten GMR-Effekt ("giant magnetoresistance") oder AMR-Effekt ("anisotropic magnetoresistance") bzw. die Sensitivität des Schichtsystems gegenüber einem äußeren, zu analysierenden Magnetfeld beschränkt.

In DE 101 40 606.1 ist beschrieben, dass zwei magnetische Schichten über eine nichtmagnetische Zwischenschicht die Richtungen ihrer jeweiligen Magnetisierungen je nach Dicke der einzelnen Schichten und deren Zusammensetzung ferromagnetisch oder antiferromagnetisch miteinander koppeln können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war die Bereitstellung eines magnetoresistiven Schichtsystems mit einer hohen und gleichzeitig möglichst temperaturunabhängigen Sensitivität gegenüber einem äußeren Magnetfeld.

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemäße magnetoresistive Schichtsystem sowie das erfindungsgemäße Sensorelement mit diesem Schichtsystem hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil einer innerhalb eines vorgegebenen Temperaturintervalls nur sehr geringen bzw. bevorzugt keiner nennenswerten Temperaturabhängigkeit seiner Sensitivität zur Detektion von äußeren Magnetfeldern hinsichtlich Stärke und/oder Richtung.

Bei bekannten magnetoresistiven Sensorelementen, die beispielsweise auf einem GMR-Schichtstapel nach dem Prinzip der gekoppelten Multilagen aufgebaut sind, verändert sich die maximale Sensitivität des Schichtstapels, die in der Regel bei Raumtemperatur erreicht werden soll, gegenüber einem äußeren Magnetfeld bzw. der Feldstärke dieses Magnetfeldes mit der Temperatur. Weiter verändert sich dessen Sensitivität auch als Funktion des innerhalb des Schichtstapels beispielsweise über eine integrierte hartmagnetische Schicht erzeugten Bias-Magnetfeldes oder Hilfsmagnetfeldes, so dass man zwar einen Arbeitspunkt des magnetoresistiven Schichtstapels einstellen kann, der von der Temperatur und der Stärke des Bias- oder Hilfsmagnetfeldes abhängig ist. Insgesamt führt dies dazu, dass sich der Arbeitspunkt des Sensorelementes bei vorgegebenen Bias-Magnetfeld als Funktion der Temperatur erheblich verschiebt, was in der Regel mit einem deutlichen Verlust an Sensitivität einher geht.

Bei dem erfindungsgemäßen magnetoresistiven Schichtsystem wird hingegen durch den speziellen Aufbau der Schichtanordnung, die ein resultierendes Magnetfeld erzeugt, das auf den magnetoresistiven Schichtstapel einwirkt, erreicht, dass sich die Sensitivität des magnetoresistiven Schichtsystems als Funktion der Temperatur nicht oder nur wenig verändert bzw. dass sich auch der Arbeitspunkt des magnetoresistiven Schichtsystems entsprechend nicht oder wenig verändert. Besonders vorteilhaft ist dabei, wenn die Schichtanordnung, die das Bias-Magnetfeld erzeugt, eine Temperaturabhängigkeit des erzeugten resultierenden Magnetfeldes aufweist, die die Temperaturabhängigkeit des magnetoresistiven Schichtstapels in dem magnetoresistiven

Schichtsystem gerade so kompensiert, dass der Arbeitspunkt des Schichtstapels nicht verschoben wird und/oder die Sensitivität gleich bleibt.

Insofern zeigt die Schichtanordnung in dem erfindungsgemäßen magnetoresistiven Schichtsystem bzw. in dem damit hergestellten Sensorelement einen Temperaturverlauf des resultierenden Magnetfeldes, der sich an den Temperaturverlauf des Arbeitspunktes des magnetoresistiven Schichtstapels anpassen lässt, während hartmagnetische Materialien, insbesondere mit hohen Curie-Temperaturen, einen intrinsischen Temperaturverlauf der Magnetisierung haben.

Während somit bei einer rein hartmagnetischen Schicht das darüber erzeugte Bias-Streumagnetfeld bzw. Hilfsmagnetfeld stets näherungsweise proportional zur Magnetisierung der hartmagnetischen Schicht ist, wird das resultierende Magnetfeld der erfindungsgemäß vorgesehenen Schichtanordnung vorteilhaft durch die Temperaturabhängigkeit der Zwischenschichtaustauschkopplung bestimmt.

So ist die Streufeldkopplung der ersten magnetischen Schicht und der zweiten magnetischen Schicht, die über die Zwischenschicht ferromagnetisch austauschgekoppelt sind, bei der vorgesehenen ferromagnetischen Zwischenschichtkopplung entgegengerichtet, d.h. in diesem Sinne antiferromagnetisch. Bei einer Abnahme der ferromagnetischen Zwischenschichtkopplung, beispielsweise durch eine Temperaturerhöhung, nimmt die antiferromagnetische Komponente relativ gesehen zu und verringert so das gesamte magnetische Streufeld der Schichtanordnung. Entsprechend verschiebt sich der zuvor eingestellte Arbeitspunkt durch die Temperaturerhöhung zu kleineren Magnetfeldern und kompensiert so eine Änderung der Sensitivität des magnetoresistiven Schichtstapels als Funktion der Temperatur. Insgesamt kann auf diese Weise die Änderung des magnetischen Streufeldes oder Bias-Magnetfeldes mit der Temperatur über die Stärke der Zwischenschichtaustauschkopplung, die eine Materialkonstante ist und damit über die gewählten Materialien bestimmt wird, sowie die Schichtdicken der ersten magnetischen Schicht und der zweiten magnetischen Schicht variiert werden.

Bei einer Übereinstimmung der Stärke des von der Schichtanordnung erzeugten resultierenden Magnetfeldes mit einem benötigten Magnetfeldwert zur Erreichung einer maximalen Sensitivität des magnetoresistiven Schichtstapels wird vorteilhaft eine besonders hohe Sensitivität des magnetoresistiven Schichtsystems bzw. des damit erzeugten Sensorelementes erreicht. Diese bleibt dann vorteilhaft über das gesamte Temperaturintervall, dem das Schichtsystem bei Be-

trieb normalerweise ausgesetzt ist, das heißt beispielsweise das Temperaturintervall von -30°C bis $+200^{\circ}\text{C}$, gleich.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den in den Unteransprüchen genannten Maßnahmen.

So ist im Fall eines magnetoresistiven Schichtsystems auf der Grundlage des GMR-Effektes nach dem Prinzip der gekoppelten Multilagen oder des Spin-Valve-Prinzips mit einer dritten magnetischen Schicht und einer vierten magnetischen Schicht, die über eine zweite, nichtmagnetische Zwischenschicht voneinander getrennt sind und die zusammen den magnetoresistiven Schichtstapel bilden, besonders vorteilhaft, wenn der magnetoresistive Schichtstapel und die Schichtanordnung einen ähnlichen oder bevorzugt gleichen Temperaturgang aufweisen, was besonders leicht dadurch erreichbar ist, dass für die zweite nichtmagnetische Zwischenschicht und die nichtmagnetische Zwischenschicht der Schichtanordnung das gleiche Material benutzt wird. Auf diese Weise zeigen Schichtanordnung und magnetoresistiver Schichtstapel eine ähnliche oder gleiche Temperaturabhängigkeit, die jeweils durch die Zwischenschichtaustauschkopplung bestimmt wird.

Weiter ist vorteilhaft, dass sich die Schichtanordnung in verschiedenen Ausführungen in die Nähe des magnetoresistiven Schichtstapels bringen lässt, d.h. sie kann bei vertikaler Integration oberhalb oder unterhalb des magnetoresistiven Schichtstapels und/oder bei horizontaler Integration einseitig oder bevorzugt beidseitig neben dem magnetoresistiven Schichtstapel angeordnet sein.

Generell vorteilhaft ist schließlich, wenn die beiden magnetischen Schichten der Schichtanordnung eine unterschiedliche Dicke aufweisen.

Zeichnungen

Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt Figur 1 einen Schnitt durch ein magnetoresistives Schichtsystem.

Ausführungsbeispiele

Die Figur 1 zeigt eine erste magnetische Schicht 12 mit einer resultierenden Magnetisierung m_1 mit der in Figur 1 angedeuteten Richtung, auf der sich eine Zwischenschicht 11 befindet. Auf der Zwischenschicht 11 ist eine zweite magnetische Schicht 13 mit einer resultierenden Magnetisierung m_2 mit der in Figur 1 angedeuteten Richtung angeordnet. Auf der zweiten magnetischen Schicht 13 befindet sich dann ein magnetoresistiver Schichtstapel 14, wie er aus dem Stand der Technik an sich bekannt ist. Insbesondere arbeitet der magnetoresistive Schichtstapel 14 auf der Grundlage des GMR-Effektes nach dem Prinzip der gekoppelten Multilagen oder nach dem Spin-Valve-Prinzip. Die erste magnetische Schicht 12, die Zwischenschicht 11 und die zweite magnetische Schicht 13 bilden zusammen eine Schichtanordnung 15, die ein resultierendes Magnetfeld erzeugt, das auf den magnetoresistiven Schichtstapel einwirkt. Weiter ist vorgesehen, dass die erste magnetische Schicht 12 und die zweite magnetische Schicht 13 über die Zwischenschicht 11 ferromagnetisch austauschgekoppelt sind.

Die erste magnetische Schicht 12 ist beispielsweise eine weichmagnetische Schicht, insbesondere eine Schicht aus Permalloy, CoFe, Co, Fe, Ni, FeNi sowie magnetischen Legierungen, die diese Materialien enthalten. Die zweite magnetische Schicht 13 ist beispielsweise eine hartmagnetische Schicht, insbesondere eine aus CoSm, CoCrPt, CoCrTa, Cr oder CoPt bestehende hartmagnetische Schicht. Alternativ kann die erste magnetische Schicht 12 auch eine hartmagnetische Schicht aus den genannten Materialien und die zweite magnetische Schicht 13 eine weichmagnetische Schicht aus den genannten Materialien sein. Daneben kann sowohl die erste magnetische Schicht 12 als auch die zweite magnetische Schicht 13 eine hartmagnetische Schicht aus CoSm, CoCrPt, CoCrTa, Cr oder CoPt sein.

Die Dicke der ersten magnetischen Schicht 12 unterscheidet sich von der Dicke der zweiten magnetischen Schicht 13. Bevorzugt ist die Dicke der zweiten magnetischen Schicht 13 größer als die der ersten magnetischen Schicht 12.

Die nichtmagnetische Zwischenschicht 11 besteht beispielsweise aus Kupfer, einer Legierung mit oder aus Kupfer, Silber und Gold, wie CuAgAu oder bevorzugt aus Ruthenium.

Im erläuterten Beispiel gemäß Figur 1 ist die Schichtanordnung 15 unter dem Schichtstapel 14 angeordnet. Sie kann jedoch ebenso auch darüber oder daneben angeordnet sein.

Die erste und/oder die zweite magnetische Schicht 12, 13 gemäß Figur 1 weisen jeweils eine Dicke zwischen 10 nm und 100 nm, insbesondere zwischen 20 nm und 50 nm, auf. Die Dicke der Zwischenschicht 11 ist derart gewählt, dass die erste magnetische Schicht 12 und die zweite magnetische Schicht 13 ferromagnetisch austauschgekoppelt sind. Sie beträgt beispielsweise 0,8 nm.

Die Deposition der einzelnen in Figur 1 erläuterten Schichten ist im Übrigen unkritisch gegenüber bekannten Einflussfaktoren. Insbesondere kann die gewünschte ferromagnetische Zwischenschichtaustauschkopplung mit Hilfe der nichtmagnetischen Zwischenschicht 11 über bekannte Schichtdicken der Zwischenschicht 11 eingestellt werden.

Temperaturschwankungen denen das magnetoresistive Schichtsystem 5 gemäß Figur 1 bei Betrieb, beispielsweise in einem Sensorelement zur Detektion von äußeren Magnetfeldern hinsichtlich Stärke und/oder Richtung, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, ausgesetzt ist, liegen in der Regel im Bereich von -30°C bis $+200^{\circ}\text{C}$.

Bei einer Erhöhung der Temperatur, beispielsweise ausgehend von Raumtemperatur, kommt es zunächst zu einem "Aufweichen" der ferromagnetischen Zwischenschichtaustauschkopplung zwischen der ersten magnetischen Schicht 12 und der zweiten magnetischen Schicht 13. Gleichzeitig ist die Streufeldkopplung der beiden gekoppelten magnetischen Schichten 12, 13 der ferromagnetischen Zwischenschichtaustauschkopplung entgegengerichtet. Insofern führt dieses Aufweichen der ferromagnetischen Schichtkopplung durch Temperaturerhöhung dazu, dass die entgegengerichtete Streufeldkopplung der magnetischen Schichten 12, 13 relativ gesehen zunimmt, so dass sich das gesamte Streufeld der Schichtanordnung 15, d. h. das auf den magnetoresistiven Schichtstapel 14 einwirkende resultierende Magnetfeld, verringert. Entsprechend wird der über die Schichtanordnung 15 eingestellte Arbeitspunkt des magnetoresistiven Schichtstapels 14 zu kleineren Magnetfeldern verschoben.

In Figur 1 ist dazu angedeutet, wie die erste magnetische Schicht 12 ein Streufeld H_1 erzeugt, das auf den magnetoresistiven Schichtstapel 14 einwirkt, und wie die zweite magnetische Schicht 13 ein Streufeld H_2 erzeugt, das ebenfalls auf den magnetoresistiven Schichtstapel 14 einwirkt.

Bei einem Aufweichen der Zwischenschichtaustauschkopplung zwischen der ersten magnetischen Schicht 12 und der zweiten magnetischen Schicht 13 verringert sich insgesamt im erläuterten Beispiel die Summe der Streufelder H_1 , H_2 , d.h. das auf den magnetoresistiven Schichtstapel einwirkende resultierende Bias-Magnetfeld.

Sofern eine der magnetischen Schichten 12, 13 eine weichmagnetische Schicht ist, beispielsweise die zweite magnetische Schicht 13, ist es sogar möglich, die beiden Streufelder H_1 und H_2 derart einzustellen, dass sie sich weitestgehend gegenseitig kompensieren.

Abschließend sei noch erwähnt, dass sich das erläuterte Konzept für die Schichtanordnung 15 problemlos in bestehende magnetoresistive Schichtsysteme mit GMR-Multilagen, GMR-Spin-Valve-Aufbau und AMR-Schichtsysteme bzw. CMR-Schichtsysteme ("colossal magnetoresistance") einfügen lässt. Zudem sei noch darauf hingewiesen, dass sich das magnetoresistive Schichtsystem 5 gemäß Figur 1 typischerweise auf einem Substrat befindet und mit diesem Substrat über eine sogenannte Buffer-Schicht verbunden ist. Weiter kann sich auf dem magnetoresistiven Schichtstapel 14 auch noch eine Deckschicht, beispielsweise aus Tantal, befinden.

Patentansprüche

1. Magnetoresistives Schichtsystem, wobei in einer Umgebung eines insbesondere auf der Grundlage des GMR- oder AMR-Effektes arbeitenden magnetoresistiven Schichtstapels (14) mindestens eine Schichtanordnung (15) vorgesehen ist, die ein resultierendes Magnetfeld erzeugt, das auf den magnetoresistiven Schichtstapel (14) einwirkt, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtanordnung (15) eine erste magnetische Schicht (12) und eine zweite magnetische Schicht (13) aufweist, die über eine nichtmagnetische Zwischenschicht (11) voneinander getrennt sind, und dass die erste magnetische Schicht (12) und die zweite magnetische Schicht (13) über die Zwischenschicht (11) ferromagnetisch austauschgekoppelt sind.
2. Magnetoresistives Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste magnetische Schicht (12) eine weichmagnetische Schicht, insbesondere eine aus Permalloy, CoFe, Co, Fe, Ni, FeNi sowie magnetischen Legierungen, die diese Materialien beinhalten, bestehende weichmagnetische Schicht, und die zweite magnetische Schicht (13) eine hartmagnetische Schicht, insbesondere eine aus CoSm, CoCrPt, CoCrTa, Cr oder CoPt bestehende hartmagnetische Schicht, ist, oder dass erste magnetische Schicht (12) eine hartmagnetische Schicht, insbesondere eine aus CoSm, CoCrPt, CoCrTa, Cr oder CoPt bestehende hartmagnetische Schicht, und die zweite magnetische Schicht (13) eine weichmagnetische Schicht, insbesondere eine aus Permalloy, CoFe, Co, Fe, Ni, FeNi sowie magnetischen Legierungen, die diese Materialien beinhalten, bestehende weichmagnetische Schicht, ist.
3. Magnetoresistives Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste magnetische Schicht (12) und die zweite magnetische Schicht (13) eine hartmagnetische Schicht, insbesondere eine aus CoSm, CoCrPt, CoCrTa, Cr oder CoPt bestehende hartmagnetische Schicht, ist.
4. Magnetoresistives Schichtsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste magnetische Schicht (12) eine von der zweiten magnetischen Schicht (13) verschiedene Dicke aufweist.

5. Magnetoresistives Schichtsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtstapel (14) eine dritte magnetische Schicht und eine vierte magnetische Schicht aufweist, die über eine zweite nichtmagnetische Zwischenschicht voneinander getrennt sind, und dass die nichtmagnetische Zwischenschicht (11) der Schichtanordnung (15) und die zweite nichtmagnetische Zwischenschicht des Schichtstapels (14) zumindest näherungsweise aus dem gleichen Material bestehen und/oder eine zumindest näherungsweise gleiche Dicke aufweisen.
6. Magnetoresistives Schichtsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nichtmagnetische Zwischenschicht (11) aus Kupfer, einer Legierung mit oder aus Kupfer, Silber und Gold oder aus Ruthenium besteht.
7. Magnetoresistives Schichtsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtanordnung (15) auf und/oder unter und/oder neben dem Schichtstapel (14) angeordnet ist.
8. Magnetoresistives Schichtsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite magnetische Schicht (12, 13) eine Dicke zwischen 10 nm und 100 nm, insbesondere 20 nm bis 50 nm, aufweist.
9. Magnetoresistives Schichtsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Änderung der Temperatur, dem das magnetoresistive Schichtsystem (5) ausgesetzt ist, innerhalb eines vorgegebenen Temperaturintervalls von insbesondere -30°C bis +200°C eine sich ändernde Sensitivität oder ein sich verschiebender Arbeitspunkt des magnetoresistiven Schichtstapels (14) gegenüber einem hinsichtlich Stärke und/oder Richtung zu messenden äußeren Magnetfeld zumindest teilweise durch das sich durch diese Temperaturänderung ebenfalls ändernde, von der Schichtanordnung (15) erzeugte resultierende Magnetfeld zumindest teilweise, insbesondere vollständig, kompensiert wird.
10. Sensorelement, insbesondere zu Detektion von Magnetfeldern hinsichtlich Stärke und/oder Richtung, mit einem magnetoresistiven Schichtsystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche.

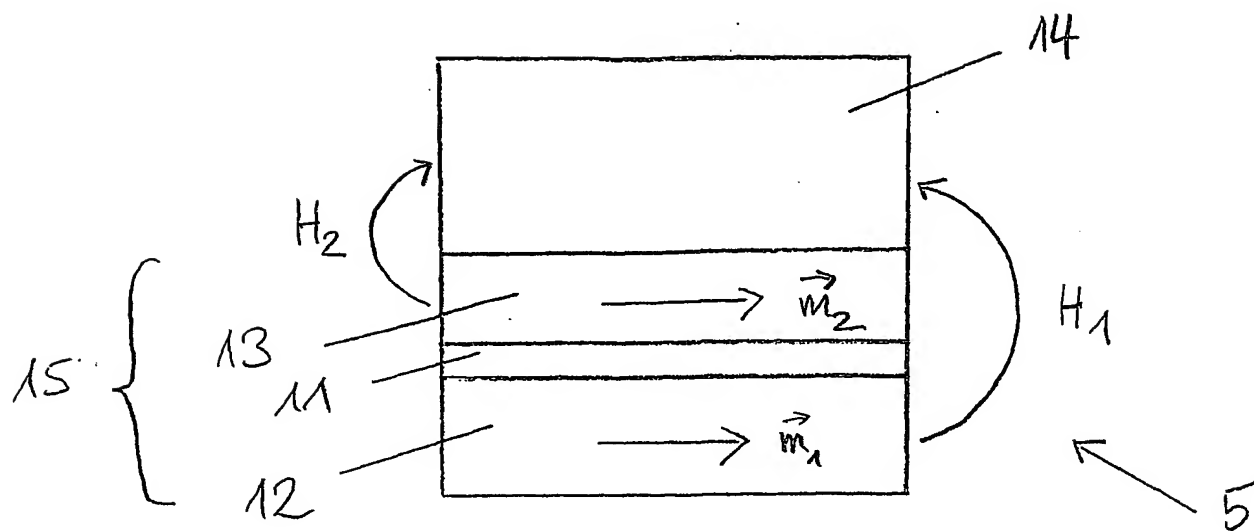


Fig. 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03503

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01R33/09

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2002/069511 A1 (UMETSU EIJI ET AL) 13 June 2002 (2002-06-13) paragraphs '0117! - '0123! -----	1,2,4,6, 7,10
A	WO 99/58994 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV ; PHILIPS SVENSKA AB (SE)) 18 November 1999 (1999-11-18) page 3, line 13 - line 26 page 4, line 23 - line 31 -----	1,2,9,10
A	US 6 348 274 B1 (IWASAKI HITOSHI ET AL) 19 February 2002 (2002-02-19) column 12, line 29 - line 52 -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 March 2004

Date of mailing of the international search report

22/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Swartjes, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/JP03/03503

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2002069511	A1	13-06-2002	JP	2002246671 A	30-08-2002
WO 9958994	A	18-11-1999	EP	1012617 A1	28-06-2000
			WO	9958994 A1	18-11-1999
			JP	2002514770 T	21-05-2002
			US	6501271 B1	31-12-2002
US 6348274	B1	19-02-2002	JP	2000252548 A	14-09-2000

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G01R33/09

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

 Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G01R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2002/069511 A1 (UMETSU EIJI ET AL) 13. Juni 2002 (2002-06-13) Absätze '0117! - '0123!	1,2,4,6, 7,10
A	WO 99/58994 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV ; PHILIPS SVENSKA AB (SE)) 18. November 1999 (1999-11-18) Seite 3, Zeile 13 - Zeile 26 Seite 4, Zeile 23 - Zeile 31	1,2,9,10
A	US 6 348 274 B1 (IWASAKI HITOSHI ET AL) 19. Februar 2002 (2002-02-19) Spalte 12, Zeile 29 - Zeile 52	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

16. März 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22/03/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Swartjes, H

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die derselben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/JP03/03503

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2002069511	A1	13-06-2002	JP	2002246671 A	30-08-2002
WO 9958994	A	18-11-1999	EP	1012617 A1	28-06-2000
			WO	9958994 A1	18-11-1999
			JP	2002514770 T	21-05-2002
			US	6501271 B1	31-12-2002
US 6348274	B1	19-02-2002	JP	2000252548 A	14-09-2000